

FMQ1A

デュアルミニモールドトランジスタ/Dual Mini-Mold Transistor
エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor
6dB アンプ/6dB Amplifier

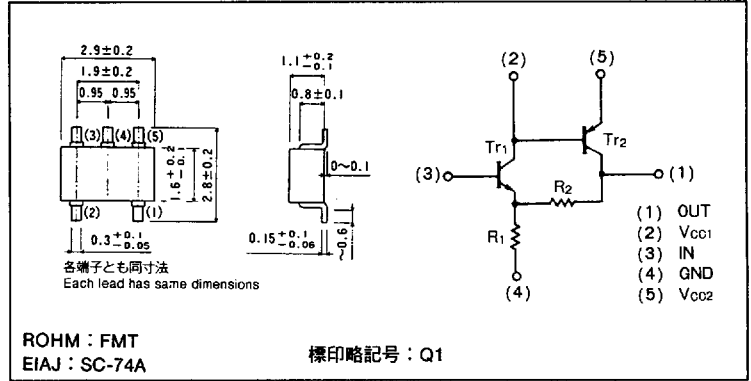
● 特長

- 1) スーパーミニモールドパッケージで、
2 個のトランジスタを内蔵している。
- 2) 6dB のゲインがとれる。

● Features

- 1) A super-minimold package houses
2 transistors.
- 2) Gain of 6dB possible.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits		Unit
		Tr1 (NPN)	Tr2 (PNP)	
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	20	-20	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	20	-20	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	5	-5	V
コレクタ電流	I _C	30	-50	mA
許容損失	P _d	200		mW
接合部温度	T _J	150		°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150		°C

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Tr1 (N P N)	コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	20	—	—	V	I _C =50 μA
	コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	20	—	—	V	I _C =1mA
	エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	5	—	—	V	I _E =50 μA
	コレクタシャ断電流	I _{CB0}	—	—	1.0	μA	V _{CB} =20V
	エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	0.5	μA	V _{EB} =4V
	直流電流増幅率	h _{FE}	120	—	560	—	V _{CE} /I _C =6V/1mA
	利得帯域幅域	f _T [*]	—	250	—	MHz	V _{CE} =10V, I _E =-5mA, f=100MHz
Tr2 (P N P)	コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	-20	—	—	V	I _C =-50 μA
	コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-20	—	—	V	I _C =-1mA
	エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-5	—	—	V	I _E =-50 μA
	コレクタシャ断電流	I _{CB0}	—	—	-1.0	μA	V _{CB} =-20V
	エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	-0.5	μA	V _{EB} =-4V
	コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE (sat)}	—	—	-0.5	V	I _C /I _B =-10mA/-1mA
	直流電流増幅率	h _{FE}	120	—	560	—	V _{CE} /I _C =-6V/-1mA
	利得帯域幅積	f _T [*]	—	140	—	MHz	V _{CE} =-12V, I _E =2mA, f=100MHz
抵抗値		R ₁ , R ₂	—	470	—	Ω	
抵抗比		R ₁ /R ₂	0.9	1.0	1.1	—	

* 構成トランジスタの特性です。

● 標準・準標準品一覧表

(○: 準標準品 △: 特別仕様)

Type	包装名	テーピング	
	記号	T148	T149
	基本発注単位 (個)	3000	3000
FMQ1A		△	○